

Цель конференции – развитие междисциплинарных подходов в исследованиях наносистем и новых материалов для нано-био-информационных и когнитивных технологий с использованием рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов.



ОРГАНИЗАТОРЫ

- Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН
- НИЦ «Курчатовский институт»
- Учреждение Российской академии наук Институт физики твердого тела РАН
- Национальный комитет кристаллографов России
- Научный совет РАН по физике конденсированных сред

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

- Российской академии наук
- Министерства образования и науки Российской Федерации
- Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
- Российского фонда фундаментальных исследований



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
М. В. Ковальчук

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
В. Л. Аксенов
Я.И. Штромбах

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ЛОКАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА
В. М. Каневский,
П.К. Кашкаров

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОНФЕРЕНЦИИ
Л. Г. Янусова



VIII НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Рентгеновское,
Синхротронное излучения,
Нейтроны и
Электроны для исследования
наносистем и материалов.
Нано-Био-Инфо-Когнитивные
технологии».
РСНЭ – НБИК 2011



14-18 ноября 2011 года
Москва
Учреждение
Российской академии наук
ИНСТИТУТ КРИСТАЛЛОГРАФИИ
им. А.В. Шубникова РАН
НИЦ «Курчатовский институт»

1-е ИЗВЕЩЕНИЕ

РСНЭ

НБИК

2011

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

будет представлена следующими секциями:

I. Биомолекулярные структуры, биосовместимые и органические материалы

Структура и свойства биомолекулярных систем, органических и биосовместимых материалов, самосборка, иерархия структур, специфические и неспецифические взаимодействия.

II. Поверхности и слоистые наносистемы

Структурные и функциональные свойства поверхности, приповерхностных слоев, тонких пленок и многослойных наносистем.

III. Структура и динамика трехмерных систем

Структура и динамика кристаллов, частично упорядоченных и разупорядоченных систем, наноструктурных материалов.

IV. Информационные и когнитивные технологии

Комплексные и междисциплинарные исследования в области когнитивных наук с использованием рентгеновского и синхротронного излучений, нейтронов, электронов и информационных технологий.

V. Численные методы, компьютерное моделирование, теория рассеяния и дифракции

Теория, алгоритмы и программы, численные эксперименты в исследовании структуры и свойств наноструктур и материалов.

VI. Аппаратурно-методическое обеспечение эксперимента

Экспериментальные станции и установки на источниках нейтронов и электронов, рентгеновского и синхротронного излучений; системы контроля, сбора, хранения и обработки информации; рентгеновская и нейтронная оптика.

В рамках конференции планируется провести: НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, посвященные памяти академика **Б.К. ВАЙНШТЕЙНА**.

Вся необходимая информация будет размещена на веб-сайте конференции <http://www.crys.ras.ru/rsne/>

ДОКЛАДЫ

будут отобраны программным комитетом на основе присланных авторами тезисов. Автор не может быть докладчиком более чем в одной работе. Тезисы объемом не более одной стандартной машинописной страницы должны быть полностью подготовлены для печати методом прямого репродуцирования. Тезисы необходимо прислать по почте (1 экземпляр и разрешение на публикацию), а также в электронном виде по e-mail **не позднее 15 мая 2011 г.** Тезисы, не соответствующие указанным требованиям, приниматься не будут.

Публикация материалов конференции планируется в журнале “Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования”, который издается на русском и английском языках издательством «Наука/Интерпериодика».

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

- заявка на участие в конференции для заполнения (в формате pdf);
- тезисы докладов (в формате doc или docx).

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 15 МАЯ 2011 ГОДА!

Присылать тезисы докладов в ИК РАН по адресу:

119333 г. Москва, Ленинский просп., 59

Учреждение Российской академии наук

Институт кристаллографии

им. А.В. Шубникова РАН.

Ученому секретарю конференции –

Янусовой Людмиле Германовне

e-mail: rsne2011@mail.ru

Тел: (499) 135-02-29; (499)135-01-00; Факс: (499) 135-10-11